

2A533A-3

Рабочий диапазон частот: 0.1 ÷ 18 ГГц;

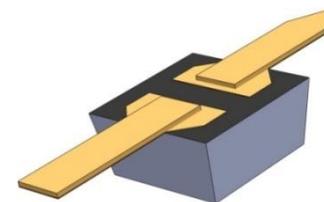
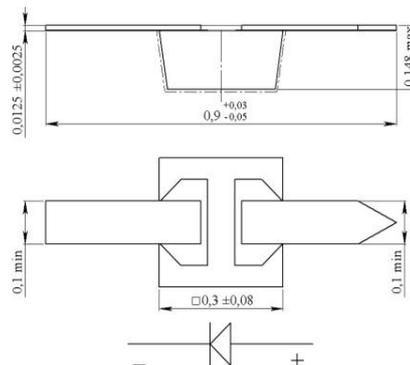
Рабочая температура окружающей среды: минус 60 °С ÷ 100 °С;

Масса (не более): 1 мг;

Бескорпусное исполнение

Технические условия: аАО.339.095 ТУ

Диод полупроводниковый бескорпусной кремниевый планарный поверхностно-ориентированный переключательный rip типа 2A533A-3, предназначенный для работы в составе гибридных интегральных схем СВЧ (ГС) в диапазоне частот от 100 МГц до 18 ГГц в аппаратуре специального назначения.



Наименование параметра, единица измерения (режим измерения)	Буквенное обозначение	2A533A-3		Температура окружающей среды (диапазон температур), °С
		Не менее	Не более	
Прямое сопротивление потерь, Ом ($I_{пр.} = 50$ мА)	$r_{пр.}$	6	8	минус 60 ÷ 25
				100
Критическая частота, ГГц ($I_{пр.} = 50$ мА, $U_{обр.} = 10$ В, $f = 4,0$ ГГц)	$f_{кр}$	200		25
Емкость диодной структуры, пФ	$C_{стр}$		0.05	25
Накопленный заряд, нКл ($I_{пр.} = 50$ мА, $U_{обр.} = 10$ В)	$q_{нк}$		15	25
Нормированное постоянное обратное напряжение, В ($I_{обр.} \leq 100$ мкА)	$U_{нрм}$	70	70	25
Пробивное напряжение, В ($I_{обр.} = 100$ мкА)	$U_{проб.}$	75		25
Время восстановления, нс	$\tau_{вос}$	50	250	25
Максимально допустимый постоянный прямой ток, мА	$I_{пр. max}$		100	минус 60 ÷ 100
Максимально допустимое постоянное обратное напряжение, В	$U_{обр. max}$		50	минус 60 ÷ 100
Максимально допустимая рассеиваемая мощность диода, мВт	$P_{рас. max}$		100	минус 60 ÷ 100